

2019 年 12 月 19 日，共 2 頁

力旺 NeoFuse 矽智財成功導入聯電 28 奈米 HV 製程 搶攻 OLED 市場

【新竹訊】 力旺電子今日宣佈一次可編程(OTP)記憶體矽智財 NeoFuse 已成功導入聯電 28 奈米高壓(HV)製程，強攻有機發光二極體(OLED)市場，關鍵客戶已經完成設計定案(Tape Out)並準備量產。

力旺業務發展中心副總何明洲表示，繼之前與聯電合作的高壓製程平台的各式解決方案，我們非常開心可以與聯電進一步在 28 奈米高壓製程的合作，因應 OLED 市場的需求，為客戶帶來最大的價值。

聯電矽智財研發暨設計支援處林子惠處長也表示，力旺 NeoFuse 矽智財與聯電 28 奈米高壓製程的合作，使我們的客戶得以客製化 IC 以符合 OLED 市場的高規需求。他更補充，不管是之前的 55 奈米、40 奈米到現在的 28 奈米高壓製程，聯電與力旺的合作成果都是非常正面的，我們客戶在各種顯示器應用市場大有斬獲，其中當然也包括 OLED 市場。

高階手機配備 OLED 顯示器已然成為趨勢，對小尺寸顯示器驅動晶片(SDDI)效能要求亦更高，這樣的需求也顯示在製程平台的選擇上，OLED 關鍵客戶逐漸從 55 奈米或 40 奈米往更先進的 28 奈米高壓製程靠攏。

28 奈米高壓製程可使高效能顯示器引擎的複雜運算能力發揮最大功能，提供 OLED 顯示器驅動晶片更快的資料存取速度，更高容量的靜態隨機存取記憶體(SRAM)及更好的功耗，同時達到高畫質與省電的目的。

聯電在 2019 年的小尺寸顯示器驅動晶片(SDDI)量產晶圓出貨量為全球之冠，其 28 奈米後閘式(Gate-Last) HKMG 製程具備優越管理漏電功耗與動態功率表現，可以提升行動裝置的電池壽命，以此為基礎，其 28 奈米高壓製程提供業界最小的靜態隨機存取記憶體(SRAM)記憶單位(Bit-cell)以減少晶片整體面積。

力旺是世界領導之邏輯非揮發性記憶體矽智財廠商，其 NeoFuse 矽智財為各種類型之應用提供低功耗、高可靠度、高安全性之解決方案，已經廣泛佈建於世界各大晶圓廠，從 0.15um 製程至先進製程節點均已佈建，未來也將繼續與晶圓廠緊密合作，為客戶創造最大利潤與價值。



關於力旺電子

力旺電子(3529)是全球知名的領導半導體矽智財供應商，專精嵌入式 Hard IP 設計。自 2000 年成立以來，力旺持續提供全球 1,550 多家晶圓廠、整合元件廠和 IC 設計公司一流的矽智財解決方案。自台積公司 2010 年創設「IP Partner Award」以來，力旺每年都以卓越的 IP 設計及服務獲得此一獎項的肯定。

力旺在全球嵌入式非揮發性記憶體市場(embedded Non-volatile Memory)位居領導地位，其 eNVM 解決方案廣泛布建於全球主要晶圓廠製程，涵蓋製程技術之廣位居業界之冠。此外，力旺也領先業界以矽晶圓生物特徵開發其特有的晶片安全矽智財。

力旺的 eNVM 矽智財系列包括可一次編寫記憶體 (NeoBit/NeoFuse)、可多次編寫記憶體 (NeoMTP/NeoFlash/NeoEE)以及晶片安全矽智財 NeoPUF。

更多力旺電子訊息，請見公司官網 www.ememory.com.tw。

關於聯電

聯華電子（紐約證券交易所代碼：UMC，台灣證券交易所代碼：2303）為全球半導體晶圓專工業界的領導者，提供成熟和先進製程的晶圓製造服務，近年來尤其專注於特殊技術，為跨越電子行業的各項主要應用產品生產晶片。聯電完整的解決方案能讓晶片設計公司利用尖端製程的優勢，包括 28 奈米 High-K/Metal Gate 後閘極技術、14 奈米量產，提供專為 AI，5G 和 IoT 應用設計的製程平台；另擁有汽車行業最高評級的 AEC-Q100 Grade-0 製造能力，可用於生產汽車中的晶片。聯電現共有十二座晶圓廠，策略性地遍及亞洲各地，每月可生產超過 70 萬片晶圓。聯電在全球約 19,500 名員工，在台灣、中國、歐洲、日本、韓國、新加坡及美國均設有服務據點，以滿足全球客戶的需求。詳細資訊，請參閱聯華電子官網：<http://www.umc.com>。

新聞聯繫

力旺電子

管理中心 趙梓羽

+886-3-5601168 #1107

irene@ememory.com.tw

聯華電子

企業訊息處 劉怡欣 Kimmy

(03)578 2258 ext. 31752

Kimmy_liu@umc.com